

Silicon Diode

1P644

100V / 400mA

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

1 P 643... 1 P 647, 1 P 649

Schnelle Silizium-Miniatur-Gleichrichter

Nennstrom 400 mA
 period. Spitzensperrspannung 50...600 V

Kunststoffgehäuse $3 \text{ } \varnothing \times 6,35$
 56 A 2 nach DIN 41 883
 Gewicht ca. 0,4 g
 Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden diese Gleichrichter gegurtet geliefert. Näheres siehe unter „Gurtung“.



Grenzwerte

Typ	periodischer Spitzensperrspannung U_{RRM} V
1 P 643	50
1 P 644	100
1 P 645	225
1 P 646	300
1 P 647	400
1 P 649	600

periodischer Spitzenstrom bei $\theta < 40^\circ$, $f > 15$ Hz	I_{FRM}	2 1)	A
Stoßstrom für eine 50-Hz-Sinus-halbwellen ausgehend von $T_j = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	15	A
Sperrschichttemperatur	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich	T_U, T_S	-55...+150	$^\circ\text{C}$

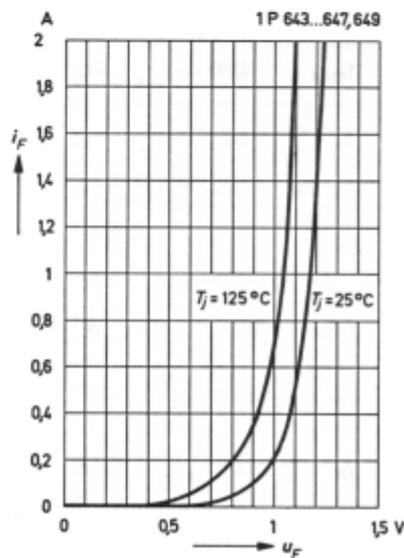
1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse Umgebungstemperatur gehalten werden.

1 P 643...1 P 647, 1 P 649

Kennwerte

Nennstrom bei $T_U = 45\text{ °C}$	I_{FAV}	400 1)	mA
Durchlaßspannung bei $I_F = 1\text{ A}$, $T_j = 25\text{ °C}$	U_F	<1,5	V
Sperrstrom bei U_{RRM} und $T_j = 25\text{ °C}$	I_R	<5	μA
Sperrverzug beim Umschalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	<500	ns
Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft	R_{thU}	<601)	K/W

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

Durchlaßkennlinien**zulässiger Richtstrom in Einwertschaltung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur**